

HYDRON® SE 230A

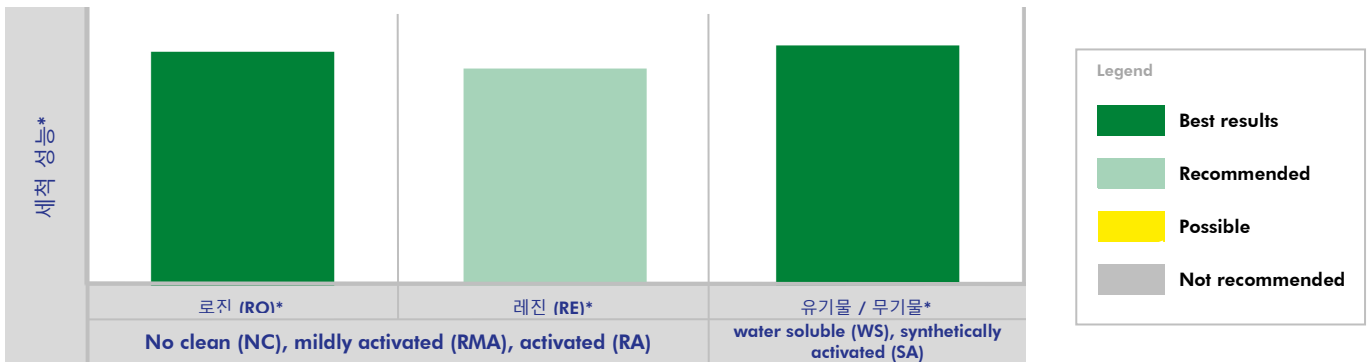


반도체 부품 세척을 위한 알칼리성 세척 용액

HYDRON® SE 230A 은 딥탱크 공정을 위해 특별히 개발된 수계 기반 단상(single-phase) 세척제입니다.

HYDRON® SE 230A 는 다이 부착 후 플립칩이나 CMOS 뿐만 아니라 리드프레임, 개별 부품, 파워 모듈, 파워 LED 등 모든 종류의 반도체 전자 제품의 플럭스를 제거하며, 와이어 본딩이나 몰딩과 같은 후속 공정을 위해 구리 표면의 산화막도 잘 제거합니다. 또한 단일 및 배치 웨이퍼 처리 장비에서 웨이퍼 범핑 후 플럭스를 제거하는데 추천됩니다.

적용 범위 - 반도체 부품 디플럭싱(Defluxing)



* J-STD-004

다른 세척제와 비교 시 이점

- HYDRON® SE 230A 은 와이어 본딩, 몰딩 및 접착제 본딩과 같은 후공정을 위해 산화막이 제거된 구리 표면을 제공하며, 활성 표면은 일정 기간 동안 유지됩니다.
- 구리, 알루미늄, 니켈과 같은 민감한 금속 소재들과 높은 수준의 호환성을 보입니다.
- 표면 장력이 낮기 때문에 미세 공간(Low stand-off 부품) 세척에 매우 효과적입니다.
- 단일 및 배치 웨이퍼 처리 장비에서 웨이퍼 범핑 후 뛰어난 세척 결과를 제공합니다.
- 단상 구조로 분리되지 않아 쉽게 세척될 수 있고 딥탱크 공정에서 뛰어난 세척 성능을 보입니다.
- 잔사 없이 DI-water 로 쉽게 린스 가능하며, 인화점이 없는 low odor 용액입니다.

공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 린스	3. 건조
초음파 (US) / 침전 스프레이 방식 (SUI)	파워 모듈, 리드프레임, 개별 소자, 파워 LED, 플립칩, CMOS	HYDRON® SE 230A	DI-water ¹	Hot air
웨이퍼 처리 장비 (스프레이, 원심 분리)	웨이퍼	HYDRON® SE 230A	DI-water	Hot air

¹ DI-water 의 온도는 20-40°C/68-104°F 를 권장합니다.